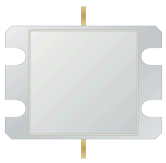
5300–5900 MHz GaN 内匹配功率晶体管 — PSAT 56.5 dBm (典型值)

LCT-5300-5900-PS56p5T · 5300–5900 MHz · GaN 内匹配功率晶体管.

RF 电气表参数: PSAT 56.5 dBm (典型值); 功率增益 12.5 dB (典型值); PAE 45 % (典型值). RF 测试条件: TA = +25 °C; VDS = 40 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 10 µs; D = 1%.



CMW025B

先加栅压，再加漏压；断电时先撤去漏压，再撤去栅压。

RF端口需外加隔直电容。

封装外形尺寸: 24.2 × 17.4 mm.

RF 特性

TA = +25 °C; VDS = 40 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 10 µs; D = 1%

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	f	5300	-	5900	MHz
饱和输出功率	-	56	56.5	-	dBm
功率增益	-	12	12.5	-	dB
功率附加效率	-	40	45	-	%
功率增益平坦度	-	-	-	1.5	dB

直流偏置与电流

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
漏极工作电压	-	-	-	-	40	V
栅极工作电压	-	-	-	-	[-4, -2]	V
夹断电压	-	-4	-	-2	VDS = 6 V; IDS ≤ 80 mA	V
栅极反向电流	-	-	-	0.01	VDS = 0 V; VGS = -10 V	A

极限参数

极限参数，不作为正常工作设定值。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
漏源最大正向电压	-	-	-	60	V
栅极最低偏置电压	-	-5	-	-	V
储存温度	-	-65	-	175	°C
最大输入功率	-	-	-	46	dBm
工作温度	-	-	-	200	°C

封装外形尺寸

参数	数值	单位
封装外形尺寸	24.2 × 17.4	mm
封装外形尺寸 (H)	-	mm

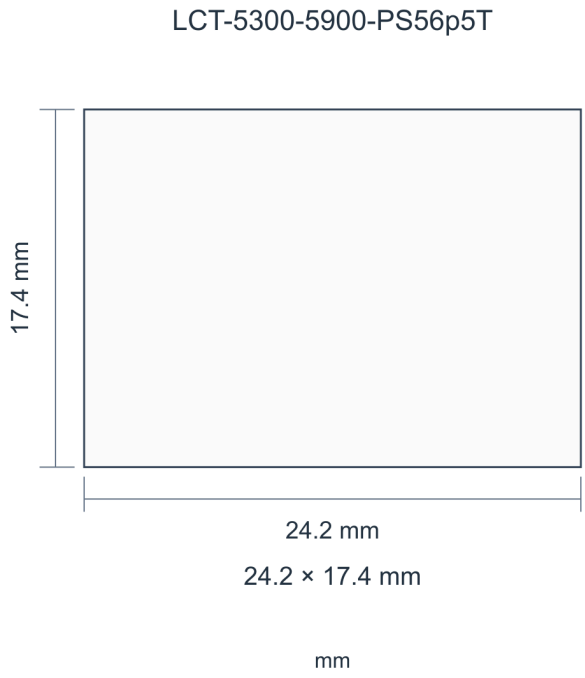
当前出版记录 · 1.6 · 2026-11-12. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.5.

集成说明

CMW025B 先加栅压，再加漏压；断电时先撤去漏压，再撤去栅压。 RF端口需外加隔直电容。 G: RF输入 D: RF输出 S: 源极／接地

机械外形尺寸图

部分尺寸参考图，已确认尺寸以 mm 标注。安装时请查阅完整安装图。

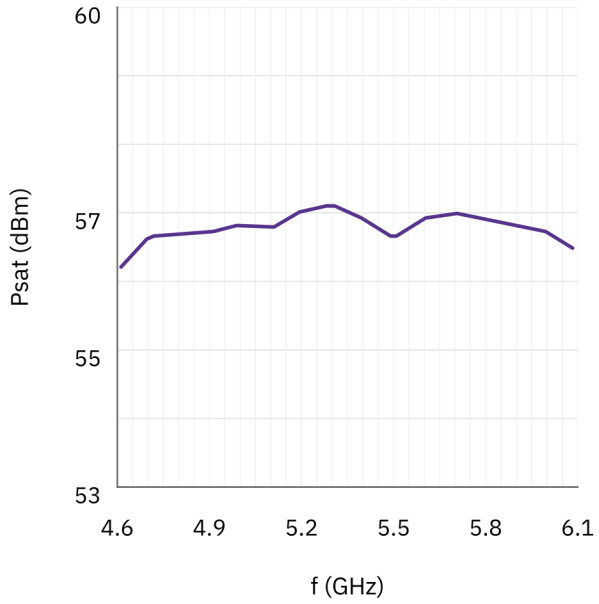


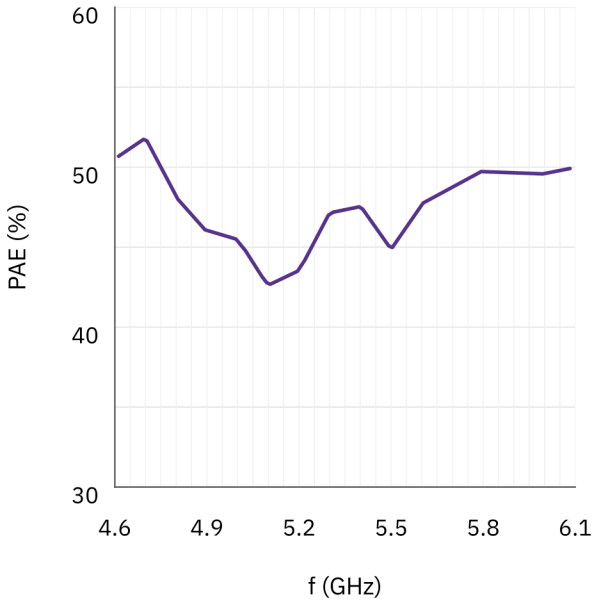
性能曲线

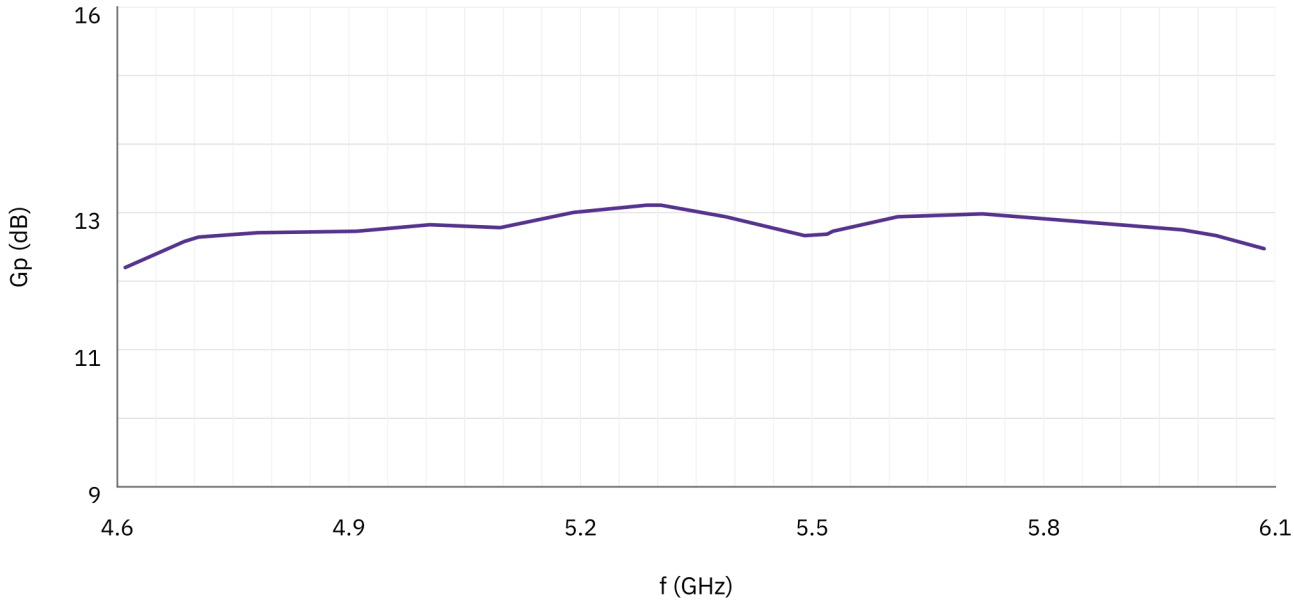
各性能曲线对应图中标注的工作条件。

输出功率、功率附加效率、功率增益。

图注： Vd=+40V; Vg=-3.1V; Pin=44dBm。 图中读数为近似值。 占空比 = 1%。







文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。